

# 实验简报

# 配备直接探测和漂移校正的 GIF Continuum

#### 标题

使用 GIF Continuum K3 在 Tb<sub>3</sub>Sc<sub>2</sub>Al<sub>3</sub>O<sub>1</sub>,中实现 ~1 Å 分辨率的 STEM EELS mapping

### 使用的 Gatan 设备

GIF Continuum® K3®

#### 背黒

电子能量损失谱 (EELS) 谱成像 (spectrum imaging, SI) 与像差校正的 STEM 相结合,可以在埃米尺度上同时表征结构和化学变化。然而,较长的采集时间、样品漂移和电子束引起的样品损伤使得原子分辨的 EELS SI 相对于环形暗场 (ADF) STEM 成像更具挑战性。直接探测单电子计数相机灵敏度更高,提升了 EELS 谱中电离边的检测极限。这使得 SI 数据可以在显著降低的总剂量下完成收集,从而减少了高空间分辨率数据采集所需的时间。结合 DigitalMicrograph® 多帧 (Multi-pass SI) 采集方式和 K3 相机的高采谱速率,总剂量被分散到多个扫描帧中,允许用户以足够高的频率进行漂移校正,从而避免图像畸变。此外,K3 相机的单电子灵敏度可防止读出噪音影响亚毫秒驻留时间下 EELS 谱的信噪比 (SNR)。

# 材料和方法

EELS SI 是使用 GIF Continuum K3 从铽钪铝石榴石 (Tb<sub>3</sub>Sc<sub>2</sub>Al<sub>3</sub>O<sub>12</sub>) FIB 样品中采集的。TEM 主机是 Thermo Fisher Scientific Spectra 300,加速电压 300 kV,电子束 流 37 pA。EELS dispersion 设置为 0.9 eV/ch, 单谱范围 >3,000 eV,使得我们能够同时采集样品中每个元素的电 离边。SI 数据以 3,000 谱每秒 (单谱 ~0.34 ms) 的速度 采集, 像素步长 0.2 Å。 每个 SI 扫描帧耗时 ~3.4 s (100 x 100 像素阵列), 采集 50 帧, 总共有效采集时间为~170 s。每两帧之间进行漂移校正。使用 DigitalMicrograph 中的内置工具进行数据处理,得出原子分辨的元素面分 布,如图1(a-d)所示。叠加图像中的Sc、Tb和O(图1f) 准确位于结构模型预测的各自位置 (图1g)。Tb 三聚体的 投影距离为~1.2 Å (图1e), 也可清晰分辨 (图1b和1f), 表明元素面分布结果的高空间分辨率。AI 元素也大致对 应于其在晶格中的位置,但精确的位置尚未解析。这是 由于 AIK 边和 Tb 信号的强烈重叠,降低了 AIK 边的信 噪比,并增加了分析过程中散射截面模型拟合的不确定

# 小结

使用 GIF Continuum K3 可以在几分钟内以 ~1 Å 级的空间分辨率进行元素面分布分析。K3 相机的高灵敏度和速度、counting EELS 的低噪声水平以及DigitalMicrograph 中的多帧 SI 功能,使用户能够以较低的总剂量收集高 SNR、无畸变的 EELS SI 数据。内置的分析工具进一步简化了获得最终结果的流程。

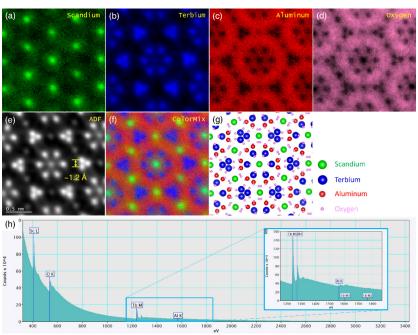


图 1. EELS SI 数据得出的元素面分布 a) Sc L, b) Tb M, c) AI K, d) O K, 以及同步收集的 ADF 像 e)。f) 各元素面分布叠加得到的组合图。g) 揭示原子位置的结构模型。h) 从 SI 数据中提取的积分 FELS 谱

### 致谢

感谢福州大学电镜中心喻志阳教授分享的样品、数据和反馈意见。